

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Факультет нано- и биомедицинских технологий

УТВЕРЖДАЮ:  
Проректор по учебно-методической работе,  
профессор

Е.Г. Елина

« 19 » 09 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

**Основы технологии материалов и компонентов электроники**

Направление подготовки бакалавриата  
03.03.02 «Физика»

Профиль подготовки бакалавриата  
«Медицинская физика»

Квалификация (степень) выпускника  
Бакалавр

Форма обучения  
очная

Саратов - 2016

## 1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы технологии материалов и компонентов электроники» является развитие у обучающихся знаний и умений использования традиционных и новых технологических процессов, операций, оборудования в профессиональной деятельности, для подготовки студентов к реализации, полученных знаний в научно-исследовательской деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

- формирование и углубление знаний традиционных и новых технологических процессов, операций, оборудования, которые непосредственно касаются возможности практической реализации нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа и учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
- формирование умений применять полученные знания к решению практических задач, выполнению теоретически исследований, выработке организационно-технических решений, касающихся основных типов современных конструкционных и функциональных неорганических (металлических и неметаллических) и органических (полимерных и углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и наноматериалов, пленок и покрытий, методов и средства контроля качества материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей и изделий, технологических процессов производства, обработки и модификации материалов и покрытий, деталей и изделий; оборудования, технологической оснастки и приспособлений; систем управления технологическими процессами;
- формирование владений навыками использования традиционных и новых технологических процессов, операций, оборудования, нормативных и методических материалов по технологической подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов с элементами экономического анализа и учетом правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда.

## 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Основы технологии материалов и компонентов электроники» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается студентами очной формы обучения факультета нано- и биомедицинских технологий СГУ, обучающимися по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» по профилю «Медицинская физика», в течение 6 учебного семестра. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные и получаемые студентами знания по курсам «Механика и молекулярная физика», «Термодинамика», «Основы физики твердого тела и полупроводниковая электроника» и подготавливает студентов к освоению дисциплины «Биомедицинские нанотехнологии», а также к выполнению выпускной квалификационной работы.

## 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Основы технологии материалов и компонентов электроники» формируется компетенция: ПК-1.

ПК-1. Способность использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен:

- знать традиционные и новые технологические процессы, операции, оборудование, нормативные и методические материалы по технологической подготовке производства, примеры реализации различных технологических процессов;
- уметь теоретически анализировать, рассчитывать, экспериментально исследовать и описывать технологию производства, обработки, модификации и переработки материалов, выбирать и оптимизировать технологические режимы;
- владеть базовыми знаниями, основными подходами и методами теоретического и экспериментального исследования технологических процессов.

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лек	Лаб	Пр	СРС	
1.	История, движущие силы и тенденции развития технологии новых материалов и структур.	6	1-2	1			2	Устный опрос
2	Физические и физико-химические основы технологических процессов.	6	1-2	2	6		3	Устный опрос на лабораторных занятиях
3	Технологии измельчения, разделения и очистки материалов	6	3-4	2	4		3	Устный опрос на лабораторных занятиях
4	Методы выращивания монокристаллов.	6	3-4	2			2	Устный опрос
5.	Технология некристаллических материалов.	6	5-7	2	4		2	Устный опрос на лабораторных занятиях
6.	Технология производства пластин и подложек.	6	5-7	2	4		2	Устный опрос на лабораторных занятиях
7.	Очистка поверхности после механической обработки.	6	8-9	2	4		2	Устный опрос на лабораторных занятиях
8.	Технология формирования эпитаксиальных структур.	6	8-9	2			2	Устный опрос
9.	Диффузионное перераспределение вещества.	6	10-11	1			2	Устный опрос

10	Окисление кремниевых пластин.	6	10-11	2	6		3	Устный опрос на лабораторных занятиях
11.	Основы плазменных и ионных технологий.	6	12-13	2			2	Устный опрос
12.	Технология ионного легирования.	6	12-13	2			2	Устный опрос
13.	Формирование тонких пленок.	6	14-15	2			2	Устный опрос
14.	Электрохимические процессы в технологии микро и наноструктур.	6	14-15	2	6		3	Устный опрос на лабораторных занятиях
15.	Технологии формирования и переноса рисунка.	6	16	2			2	Устный опрос
16.	Методы нанолитографии	6	16	2			2	Устный опрос
17.	Технологии сборки, пассивации и защиты.	6	17	2			2	Устный опрос
18	Особенности технологии наноматериалов и наноструктур.	6	17	2			2	Устный опрос
	<b>Итого:</b>			<b>34</b>	<b>34</b>		<b>40</b>	<b>Контрольная работа Экзамен (36 ч.)</b>

### Содержание дисциплины

- История, движущие силы и тенденции развития технологии новых материалов и структур.** Микро- и нанотехнологии. Технологии от нано к био и от био к нано. Социально-экономические последствия развития технологии новых материалов, микро и нанотехнологий. Перспективы, потенциальные опасности и этические аспекты развития новых технологий. Основы технологии материалов и компонентов электроники как совокупность способов и процессов. Основные стадии. Методы анализа технологических процессов. Производственная гигиена. Чистота материалов и помещений. Классификация материалов по чистоте. Маркировка материалов. Основные и вспомогательные материалы в микро и нанотехнологиях.
- Физические и физико-химические основы технологических процессов.** Движущие силы технологического процесса. Массо- и теплопередача в гетерогенных системах. Явления на границах раздела фаз и фазовые переходы. Гидродинамический, тепловой и диффузионный пограничные слои. Химические превращения в гетерогенных системах. Лимитирующая стадия технологического процесса. Активное состояние. Метастабильные состояния. Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование. Особенности зародышеобразования и роста кристаллов и пленок из пара, жидкости и твердой фазы. Влияние примесей и дефектов на зародышеобразование и рост.
- Технологии измельчения, разделения и очистки материалов.** Механическое измельчение и разделение материалов по фракциям. Сорбционные процессы. Ионный обмен. Хроматография. Жидкостная экстракция. Ректификация. Химические транспортные реакции. Электрохимические методы очистки. Разделение в силовых полях. Направленная кристаллизация.
- Методы выращивания монокристаллов.** Направленная кристаллизация, вытягивание из расплава, зонная плавка, выращивание из раствора, кристаллизация на реальных поверхностях. Распределение примесей и дефекты при зонной плавке, направленной кристалли-

- зации и вытягивании из расплава. Методы выравнивания состава. Радиационное легирование. Профилирование. Примеры: технология монокристаллического кремния, технология арсенида галлия.
5. **Технология некристаллических материалов.** Стекла. Механизм размягчения и плавления. Виды стекол. Силикатное стекло. Стекловарение оксидных стекол. Получение пленок стекла. Керамики и ситаллы. Подготовка массы. Формование. Сушка. Обжиг. Механизм спекания.
  6. **Технология производства пластин и подложек.** Подготовительные операции в производстве интегральных схем. Абразивная обработка. Механизм возникновения трещин и разрушения кристаллов. Нарушенный слой после механической обработки. Типы и основные характеристики подложек. Резка слитков и изготовление пластин. Шлифовка и полировка пластин. Скрайбирование и разлом пластин.
  7. **Очистка поверхности после механической обработки.** Химическая обработка пластин. Полирующие и анизотропные травители. Локальное и локально-анизотропное травление. Селективность травления. Травление оксида и нитрида кремния. Промывка пластин в воде. Ограничения жидкостного травления. Химико-механическое полирование. Жидкостное, термохимическое газовое и плазموхимическое травление. Полирующее травление в парогазовых смесях. Вакуумно-термическое испарение.
  8. **Технология формирования эпитаксиальных структур.** Методы получения эпитаксиальных пленок кремния (хлоридный, пиролиз моносилана). Гетероэпитаксия кремния. Молекулярно лучевая эпитаксия. Особенности эпитаксии из газовой, жидкой и твердой фаз.
  9. **Диффузионное перераспределение вещества.** Распределение примесей при диффузии. Источники примесей. Легирование диффузией. Граничные условия. Методы реализации. Диффузионные структуры. Стимулирование диффузии. Радиационно-стимулированная диффузия. Электродиффузия. Технология диффузионных процессов получения легированных слоев. Границы раздела при получении легированных эпитаксиальных слоев.
  10. **Окисление кремниевых пластин.** Высокотемпературное окисление кремния. Адсорбция. Переход адсорбированных частиц в кристаллическую решетку. Диффузия. Фазовые превращения при окислении. Кинетика окисления. Особенности высокотемпературного окисления кремния сухим и влажным кислородом. Анодное окисление. Структура оксида.
  11. **Основы плазменных и ионных технологий.** Классификация и особенности методов обработки материалов в плазме и пучках энергетических частиц. Воздействие пучков электронов, атомов и ионов на поверхность и объем мишени. Вторичные эффекты в мишени. Упругое и неупругое рассеяние электронов. Энергетические потери. Пробег. Обратное рассеяние. Вторичные электроны. Рентгеновское излучение. Виды электрических разрядов в газе. Потенциалы в плазме. Источники ионов. Источники электронов. Процессы, сопровождающие травление в плазме. Создание химически активных частиц в плазме. Доставка частиц к поверхности и кинетика травления. Загрузочный эффект. Механизм травления кремния, оксида и нитрида кремния в плазме. Распыление твердых тел ионами.
  12. **Технология ионного легирования.** Пробег ионов в кристаллических и аморфных материалах. Маскирование при ионном легировании. Распределение внедренных ионов. Дефектообразование при имплантации. Влияние радиационных дефектов на структуру поверхности. Виды дефектов. Образование. Миграция. Влияние на диффузию и свойства материалов. Технологии стабилизации свойств материала. Методы отжига дефектов после ионного легирования. Лазерный отжиг. Электронно-лучевой отжиг. Лазерное и электронно-лучевое перемешивание. Точечные дефекты в поле упругих деформаций. Геттерирование точечных дефектов.
  13. **Формирование тонких пленок.** Оборудование и методы нанесения пленок в вакууме, молекулярных пучках, химическим осаждением из газовой фазы, жидкофазной эпитаксией, атомно-молекулярной сборкой. Формирование тонких пленок ионно-плазменным распылением. Метод магнетронного распыления. Молекулярно лучевая эпитаксия. Формиро-

вание диэлектрических пленок. Термическое окисление кремния. Плазмохимическое получение пленок нитрида и оксида кремния. Формирование проводящих пленок. Материалы для металлизации. Технология многоуровневой разводки.

14. **Электрохимические процессы в технологии микро и наноструктур.** Анодное растворение. Анодное окисление. Катодное осаждение. Темплатное осаждение наноразмерных объектов.
15. **Технологии формирования и переноса рисунка.** Виды литографии. Основные этапы процесса фотолитографии. Технология изготовления фотошаблонов. Дефекты фотошаблонов. Основные системы экспонирования. Контактная и проекционная литография. Фоторезисты, методы их нанесения и обработки. Ограничения разрешающей способности при фотолитографии. Фотолитография в глубокой ультрафиолетовой области.
16. **Методы нанолитографии.** Электронолитография. Электронорезисты. Ионная литография. Рентгенолитография. Источники излучения в фотолитографии, рентгеновской литографии и электронно лучевой литографии. Силовая и токовая зондовые литографии. Контактное формирование нанорельефа. Профилирование резистов сканирующими зондами. Локальная глубинная модификация поверхности. Термомеханическая нанолитография. Нанопечать. Перьевая нанолитография. Литография наносферами. Литографически индуцированная самосборка наноструктур. Сопоставление методов нанолитографии.
17. **Технологии сборки, пассивации и защиты.** Герметизация в металлических, пластмассовых, керамических корпусах. Процессы сварки и пайки в технологии микроэлектроники.
18. **Особенности технологии наноматериалов и наноструктур.** Размерные эффекты и условия их проявления. Кластеры. Наночастицы. Нанопорошки. Наноструктуры. Тонкие пленки. Методы получения нанопорошков. Технологии формирования наноструктур. Зондовые технологии. Саморегулирующиеся процессы. Технологии формирования приборов микро- нано- и оптоэлектроники, микро и нано- машин.

#### **Перечень лабораторных работ (примерный)**

1. Измерение плотности дислокаций и дефектов в эпитаксиальных пленках.
2. Определение толщины эпитаксиального слоя методом сферического шлифа.
3. Анодное окисление кремния.
4. Высокотемпературное окисление кремния.
5. Диффузия бора в кремнии.
6. Травление кремния.
7. Изготовление термопары в дуговом разряде.
8. Термокомпрессия.

Описания лабораторных работ даны в учебном пособии:

Технология материалов электронной техники : лаб. практикум : учеб. пособие для студентов фак. нано- и биомед. технологий / под общ. ред. С. В. Стецюра, Е. Г. Глуховского ; Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : ООО "Ред. журн. "Промышленность Поволжья" ; Изд. дом "GrishineL", 2008. - 174 с. (хранится в библиотечном фонде кафедры материаловедения, технологии и управления качеством)

#### **5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины**

При реализации различных видов учебной работы (лекции, лабораторные самостоятельная работа) используются следующие современные образовательные технологии:

- информационно-коммуникационные технологии;
- проблемное обучение.

Лекционные занятия проводятся в основном в традиционной форме. До 15% лекционных часов отводится для встреч с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций. При проведении части лекционных занятий используется ПК и мультимедийный проектор.

### **Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:**

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей использовать крупноформатные наглядные материалы;
- организация коллективных занятий в студенческих группах с целью оказания помощи в получении информации инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью;
- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- использование индивидуальных графиков обучения
- использование дистанционных образовательных технологий

### **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.**

В преподавании дисциплины «Основы технологии материалов и компонентов электроники» используются контрольные задания учебных пособий, перечень которых приведен в разделе 8.

При выполнении самостоятельной работы обучающийся сначала прорабатывает материал лекций и лабораторных занятий, затем основную и дополнительную литературу в части, соответствующей графику изучения дисциплины (раздел 4). После этого обучающийся выполняет задания для самоконтроля рекомендованных учебных пособий и назначенные преподавателем задачи.

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется во время проведения лабораторных занятий, промежуточная аттестация в конце семестра. Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости являются контрольные задания из учебных пособий, рекомендованных в качестве основной литературы.

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по окончании курса.

Оценочными средствами для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины являются контрольные вопросы, приведенные ниже в разделе «**Вопросы для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины**».

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в течение всего периода изучения и заключается в чтении и изучении литературы, подготовке к лекциям и лабораторным занятиям, в выполнении заданий лектора. Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствие со структурой и содержанием дисциплины (раздел 4) и складывается из проработки лекционного материала, материала лабораторных работ, рекомендуемой основной и дополнительной литературы (раздел 8), выполнения контрольных заданий учебных пособий, разбора и решения задач из рекомендуемых в разделе 8 задачников. Самостоятельная работа выполняется в разнообразных формах в следующем порядке. Сначала прорабатывается материал лекций. Результаты освоения лекционного материала используются при изучении теоретического материала соответствующего раздела учебника, рекомендованного в качестве основной литературы. Расширение и углубление знаний и понимания проводится с помощью рекомендованной дополнительной литературы. Самоконтроль приобретенных знаний осуществляется путем выполнения заданий основного учебника, приведенных в конце каждого раздела и решения задач по теме из основного рекомендованного задачника. Наконец проводится подготовка к текущему контролю освоения дисциплины в форме устного опроса на лабораторных занятиях.

Рекомендуется:

- для качественного усвоения материала лекций разбирать вопросы, изложенные в каждой очередной лекции, по непонятым деталям консультироваться у лектора, читать соответствующую литературу;

- при подготовке к лабораторным занятиям пользоваться рекомендациями преподавателя, ведущего лекции, готовить краткий конспект по вопросам темы, изучать рекомендуемую основную и дополнительную литературу;

- задания, которые даются лектором во время лекции по отдельным вопросам, обязательны для выполнения, и качество их выполнения будет проверяться во время экзамена.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины выбираются из приведенного ниже списка в соответствии со структурой и содержанием дисциплины (раздел 4).

**Вопросы для текущего контроля в форме устного опроса на лабораторных занятиях**

1. Перспективы, потенциальные опасности и этические аспекты развития новых технологий.
2. Чистота материалов и помещений.
3. Классификация материалов по чистоте.
4. Маркировка материалов.
5. Основные и вспомогательные материалы в микро и нанотехнологиях.
6. Массо- и теплопередача в гетерогенных системах.
7. Явления на границах раздела фаз и фазовые переходы.
8. Химические превращения в гетерогенных системах.
9. Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование.
10. Механическое измельчение и разделение материалов по фракциям.
11. Сорбционные процессы.
12. Ионный обмен.
13. Хроматография.
14. Жидкостная экстракция.
15. Ректификация.
16. Электрохимические методы очистки.
17. Направленная кристаллизация.
18. Распределение примесей и дефекты при зонной плавке, направленной кристаллизации и вытягивании из расплава.
19. Радиационное легирование.
20. Технология монокристаллического кремния.
21. Технология арсенида галлия.
22. Механизм размягчения и плавления.
23. Силикатное стекло.
24. Получение пленок стекла.
25. Керамики и ситаллы.
26. Механизм спекания.
27. Механизм возникновения трещин и разрушения кристаллов.
28. Нарушенный слой после механической обработки.
29. Типы и основные характеристики подложек.
30. Резка слитков и изготовление пластин.
31. Шлифовка и полировка пластин.
32. Скрайбирование и разлом пластин.
33. Химическая обработка пластин.
34. Полирующие и анизотропные травители.
35. Локальное и локально-анизотропное травление.



36. Селективность травления. Травление оксида и нитрида кремния.
37. Ограничения жидкостного травления.
38. Химико-механическое полирование.
39. Жидкостное, термохимическое газовое и плазмохимическое травление.
40. Методы получения эпитаксиальных пленок кремния (хлоридный, пиролиз моносилана).
41. Гетероэпитаксия кремния.
42. Молекулярно лучевая эпитаксия.
43. Особенности эпитаксии из газовой, жидкой и твердой фаз.
44. Распределение примесей при диффузии.
45. Источники примесей.
46. Легирование диффузией.
47. Диффузионные структуры.
48. Радиационно-стимулированная диффузия.
49. Электродиффузия.
50. Высокотемпературное окисление кремния.
51. Адсорбция.
52. Фазовые превращения при окислении.
53. Кинетика окисления.
54. Особенности высокотемпературного окисления кремния сухим и влажным кислородом.
55. Анодное окисление.
56. Классификация и особенности методов обработки материалов в плазме и пучках энергетических частиц.
57. Воздействие пучков электронов, атомов и ионов на поверхность и объем мишени. Вторичные эффекты в мишени.
58. Потенциалы в технологической плазме.
59. Источники ионов.
60. Источники электронов.
61. Процессы, сопровождающие травление в плазме.
62. Загрузочный эффект.
63. Механизм травления кремния, оксида и нитрида кремния в плазме.
64. Распыление твердых тел ионами.
65. Пробег ионов в кристаллических и аморфных материалах.
66. Маскирование при ионном легировании.
67. Распределение внедренных ионов.
68. Дефектообразование при имплантации.
69. Влияние радиационных дефектов на структуру поверхности.
70. Методы отжига дефектов после ионного легирования.
71. Оборудование и методы нанесения пленок в вакууме, молекулярных пучках, химическим осаждением из газовой фазы, жидкофазной эпитаксией, атомно-молекулярной сборкой.
72. Метод магнетронного распыления.
73. Молекулярно лучевая эпитаксия.
74. Материалы для металлизации.
75. Технология многоуровневой разводки.
76. Анодное растворение.
77. Анодное окисление.
78. Катодное осаждение.
79. Темплатное осаждение наноразмерных объектов.
80. Виды литографии.
81. Основные этапы процесса фотолитографии.

82. Технология изготовления фотошаблонов.
83. Дефекты фотошаблонов.
84. Основные системы экспонирования.
85. Фоторезисты, методы их нанесения и обработки.
86. Ограничения разрешающей способности при фотолитографии.
87. Фотолитография в глубокой ультрафиолетовой области.
88. Электронолитография.
89. Ионная литография.
90. Рентгенолитография.
91. Источники излучения в фотолитографии, рентгеновской литографии и электронно лучевой литографии.
92. Силовая и токовая зондовые литографии.
93. Контактное формирование нанорельефа.
94. Профилирование резистов сканирующими зондами.
95. Локальная глубинная модификация поверхности.
96. Термомеханическая нанолитография.
97. Нанопечать.
98. Перьевая нанолитография.
99. Литография наносферами.
100. Литографически индуцированная самосборка наноструктур.
101. Герметизация в металлических, пластмассовых, керамических корпусах.
102. Процессы сварки и пайки в технологии микроэлектроники

### **Задания для контрольной работы (примерные)**

1. Обосновать выбор метода разделения следующих веществ:
  - этиловый и метиловый спирт;
  - коллоидные частицы серебра в воде;
  - эмульсия масла в воде;
  - вода, четыреххлористый углерод.
2. Рассчитать степень разделения бинарного раствора методом дистилляции для указанных начальных концентраций и целевого выхода продукта.
3. Обосновать выбор экстрагента при жидкостной экстракции для извлечения следующего вещества из воды:
  - уксусная кислота;
  - ацетон;
  - фенол.
4. Описать метод выращивания монокристаллов:
  - Метод Чохральского;
  - Метод Бриджмена;
  - Метод направленной кристаллизации;
  - Метод зонной плавки;
  - Гидротермальный метод.
5. Рассчитать толщину оксида кремния сформированного термическим окислением при заданном режиме:
  - время 20 мин, температура 950°C, пары воды;
  - время 30 мин, температура 850°C, сухой кислород;
  - время 40 мин, температура 1000°C, влажный кислород.
6. Обосновать выбор технологического режима диффузионного легирования для получения заданной глубины p-n перехода:

- Исходное легирование – бор 1020 см<sup>-3</sup>, глубина p-n перехода 0,5 мкм.
- Исходное легирование – фосфор 1021 см<sup>-3</sup>, глубина p-n перехода 1,5 мкм.

### Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по итогам освоения дисциплины

1. История, движущие силы и тенденции развития технологии новых материалов и структур.
2. Физические и физико-химические основы технологических процессов.
3. Технологии измельчения, разделения и очистки материалов
4. Методы выращивания монокристаллов.
5. Технология некристаллических материалов.
6. Технология производства пластин и подложек.
7. Очистка поверхности после механической обработки.
8. Технология формирования эпитаксиальных структур.
9. Диффузионное перераспределение вещества.
10. Окисление кремниевых пластин.
11. Основы плазменных и ионных технологий.
12. Технология ионного легирования.
13. Формирование тонких пленок.
14. Электрохимические процессы в технологии микро и наноструктур.
15. Технологии формирования и переноса рисунка.
16. Методы нанолитографии
17. Технологии сборки, пассивации и защиты.
18. Нанообъекты и наноматериалы.
19. Методы получения нанопорошков и технологии формирования наноструктур.
20. Наноструктурированные материалы.
21. Зондовые технологии.
22. Саморегулирующиеся процессы.
23. Технологии формирования приборов микро- нано- и оптоэлектроники, микро и наномашин

## 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

### 7.1. Учебный рейтинг по дисциплине «Основы технологии материалов и компонентов электроники» при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в семестре при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена.

1	2	3	4	5	6	7	8
Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
10	40	0	20	0	10	20	100

*Программа оценивания учебной деятельности студента*

**Лекции** – от 0 до 10 баллов

Учитывается посещение занятий и активное участие в устных опросах по пройденному материалу.

**Лабораторные занятия** – от 0 до 40 баллов

Выполнения предусмотренных рабочей программой лабораторных работ – от 0 до 5 баллов за каждую из 8 работ. Оценивается оформление отчета и правильность выполнения задания.

**Практические занятия.** Не предусмотрены

**Самостоятельная работа**

Оцениваются ответы на контрольные вопросы по лабораторным работам.

**Автоматизированное тестирование.** Не предусмотрено.

**Другие виды учебной деятельности:** – от 0 до 10 баллов

Оценивается правильность выполнения контрольной работы.

**Промежуточная аттестация (экзамен)**

Во время промежуточной аттестации используется следующая шкала ранжирования:

**15-20 баллов** – ответ на «отлично»

**10-14 баллов** – ответ на «хорошо»

**5-9 баллов** – ответ на «удовлетворительно»

**0-4 баллов** – неудовлетворительный ответ.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента в семестре по дисциплине «Основы технологии материалов и компонентов электроники» составляет 100 баллов.

Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы технологии материалов и компонентов электроники» в оценку (экзамен) осуществляется в соответствии с таблицей 2

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы технологии материалов и компонентов электроники» в оценку

81-100 баллов	«отлично»
65-80 баллов	«хорошо»
50-64 баллов	«удовлетворительно»
0-49 баллов	«не удовлетворительно»

Текущие индивидуально набранные студентами баллы доводятся до их сведения 2 раза за семестр: в конце 7 и 13 недель обучения.

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### а) основная литература:

1. Раскин А.А., В. К. Прокофьева В.К. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники ч. 1 - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 163 с. **Гриф УМО** (в НБ СГУ 45 экз.)
2. Рощин В.М., Силибин М.В. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники ч. 2. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. 179 с. **Гриф УМО** (в НБ СГУ 45 экз.)
3. Капустин В. И., Сигов А. С. Материаловедение и технологии электроники [**Электронный ресурс**] : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 427 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=416461>. - ЭБС "ИНФРА-М"

### б) дополнительная литература:

1. Неволин В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике [**Электронный ресурс**]. - Москва: Техносфера, 2014. - 176 с. – Режим доступа: <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-94836-382-0>.- ЭБС "АЙБУКС"
2. Орликов Л. Н Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1. [**Электронный ресурс**] : учебное пособие. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 98 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
3. Орликов Л. Н Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 2. [**Электронный ресурс**] : учебное пособие. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 100 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
4. Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Технология полупроводниковых и диэлектрических приборов - СПб. : Лань, 2002. - 422 с. (в НБ СГУ 11 экз.)
5. Барыбин А. А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 423 с. **Гриф** (в НБ СГУ 8 экз.)
6. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий: в 2 т. / под общ. ред. Ю. Н. Коркишко. Т. 1 : Физико-химические основы технологии микроэлектроники / Ю. Д. Чистяков, Ю. П. Райнова. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 392 с. (в НБ СГУ 15 экз.)
7. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: в 2 т. / под общ. ред. Ю. А. Чаплыгина. Ч. 1 : Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование / Королёв М. А., Крупкина Т. Ю., Ревелева М. А.. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. – 396 с. **Гриф** (в НБ СГУ 30 экз.)
8. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: учеб. пособие : в 2 т. под общ. ред. Ю. А. Чаплыгина. Ч. 2 : Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования. / Королёв М. А., Крупкина Т. Ю., Путря М.Г., Шевяков В.И. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2009. - 422 с. **Гриф** (в НБ СГУ 30 экз.)
9. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси ; пер. с яп. А. В. Хачояна ; под ред. Л. Н. Патрикеева. - 2-е изд. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 134 с. (в НБ СГУ 12 экз.)
10. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. - 2-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2009. - 414 с. (в НБ СГУ 45 экз.)

### в) рекомендуемая литература:

1. Технология производства полупроводниковых приборов [Текст] : учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальности "Полупроводники и диэлектрики" / А. И. Курносов, В. В. Юдин. - Москва : Высш. шк., 1974. - 400 с. (в НБ СГУ 3 экз.)

2. Малкович Р. Ш. Математика диффузии в полупроводниках. - СПб. : Наука, 1999. - 389 с. (в НБ СГУ 1 экз.)
3. Красников Г. Я., Зайцев Н. А. Физико-технологические основы обеспечения качества СБИС, ч. 1 - М. : Микрон-Принт, 1999. 226 с. (в НБ СГУ 1 экз.)
4. Дубровский В. Г. Теория формирования эпитаксиальных наноструктур - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 350 с. (в НБ СГУ 1 экз.)
5. Красников Г. Я., Зайцев Н. А. Физико-технологические основы обеспечения качества СБИС, ч. 2 - М. : Микрон-Принт, 1999. - 216 с. (в НБ СГУ 1 экз.)
6. Козловский В. В. Модифицирование полупроводников пучками протонов. - СПб. : Наука, 2003. - 267 с. (в НБ СГУ 2 экз.)
7. Гаврилов С.А., Белов А.Н. Электрохимические процессы в технологии микро- и нано-электроники - М. : Высш. образование, 2009. - 257 с. Гриф (в НБ СГУ 1 экз.)
8. Методы нанолитографии. Достижения и перспективы /Г. С. Константинова [и др.]; науч. ред. В. Н. Лозовский. - Ростов н/Д : ТЕРРА-ПРИНТ, 2008. - 112 с. (в НБ СГУ 1 экз.)

#### г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Windows XP Prof
2. Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations
3. Microsoft Office профессиональный 2010
4. MathCad 14.0
5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/window/>
6. Зональная научная библиотека им. В.А.Артисевич Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского. – Режим доступа: <http://library.sgu.ru/>

### 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины


Занятия по дисциплине «Основы технологии материалов и компонентов электроники» частично проводятся в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой и проекторами. Оборудование и возможности учебно-научной лаборатории технологии материалов и покрытий описаны на сайте лаборатории. При выполнении лабораторных работ используется следующее оборудование:

- 1) установка плазмохимического осаждения диэлектрических слоев типа УВП-2М (МЭП СССР), оснащенная магнетронным распылительным узлом, системой ВЧ очистки и ВЧ смещения подложек;
- 2) шкафы вытяжные, химически стойкие 1200 ШВМкв-ХС для хранения баллонов со сжатыми газами (С.-Петербург);
- 3) металлографический цифровой комплекс "Альтами-MET1" (С.-Петербург);
- 4) линейные программируемые источники питания:PST-3201 ("Instek GoodWill", Тайвань), LPS-304, LPS-305 ("Motech Inc.", Тайвань);
- 5) цифровые программируемые мультиметры Keithley-2000, Keithley-2000/20 ("Keithley", США);
- 6) регуляторы расхода газа "Bronkhorst High Tech" (Нидерланды);
- 7) генератор чистого воздуха ГЧВ-1,2-3,5 (Москва);
- 8) аналитические весы Shinko AF-R220CE (Япония);
- 9) вискозиметр SV-100 (Япония);
- 10) алмазный скрайбер RV-129 (Германия);
- 11) ультразвуковая ванна "Techsonic" (США);
- 12) центрифуга "Sigma" (Германия);
- 13) прибор для получения чистой воды "Водолей" (Москва);
- 14) мембранный дисциллятор ДМЭ/Б.2э (Владимир);
- 15) рН-метр "ino-Lab pH 730" (Германия).


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 03.03.02 «Физика» и профилем «Медицинская физика».

Программа разработана в 2014 г. (одобрена на заседании кафедры материаловедения, технологии и управления качеством от 01.09. 2014 г., протокол № 1).

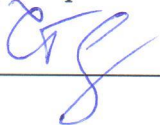
Программа актуализирована в 2016 г. (одобрена на заседании кафедры материаловедения, технологии и управления качеством от 12.09. 2016 г., протокол № 2).

Автор: доцент кафедры материаловедения,  
технологии и управления качеством,  
к.ф.-м.н.  Синёв И.В.

Зав. кафедрой материаловедения, технологии и управления качеством,  
д.ф.-м.н., профессор

  
С.Б. Вениг

Декан факультета нано- и биомедицинских  
технологий, профессор

  
С.Б. Вениг